PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

04-305917

(43)Date of publication of application: 28.10.1992

(51)Int.CI.

H01L 21/027

(21)Application number: 03-094863

(71)Applicant: NIKON CORP

(22)Date of filing:

02.04.1991

(72)Inventor: OZEKI HISAO

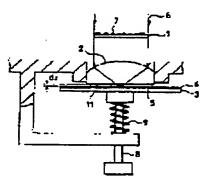
MATSUBARA TAKASHI

(54) ADHESION TYPE EXPOSURE DEVICE

(57) Abstract:

PURPOSE: To thin film thickness of an immersion liquid and reduce the quantity of light absorbed, and to minimize and prevent exposure unevenness in an adhesion type exposure device.

CONSTITUTION: The adhesive surface 11 of an exposure lens is hydrophilic—treated by a hydrophilic solution such as alcohol. A wafer 3 coated with a photoresist 4 is fast stuck on the hydrophilic—treated adhesive surface 11 through an immersion liquid 5, and the pattern 7 of a photomask 1 is transferred onto the wafer 3 by the irradiation of irradiation light 6. Wafer absorbing properties are improved in the hydrophilic—treated adhesive surface 11, and the film thickness of the immersion liquid 5 is made thin.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

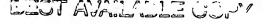
[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]



(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出關公司各号

特開平4-305917

(43)公問日 平成4年(1992)10月28日

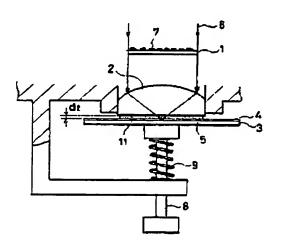
(51) Int CL's H 0 1 L 21/02	級別配号 77	庁内整理番号 7018—4M 7352—4M	FJ			技術表示管所
200 2 200	•		H01L	21/39	S A	
				穿蓋研求 未	京本語 水泉	質の数1(全 3 頁)
(21) 出題番号	特爾平3-94863		(71)出頭人	000004112		
(22) 出頭日	平成3年(1991)4	月2日		练式会社二: 東京都千代B		3丁目2番3号
			(72) 発明者	大岡 尚夫		
				東京都品川区会社ニコンプ		自6番3号 株式
			(72) 発明者	•	N PHENET PURITY	¥
						百648号 禁蚊

(54) 「発明の名称」 密着型質光装置

(57) 【要約】

【目的】 布奈型爆光装置において、長液の順序を持く して光の吸収息を少なくし、電光ムラを軽減助止するこ とを目的とする。

【特成】 解光レンズの参差面11をアルコール等の根本溶液によって最水化処理する。この根水化処理された管着面11にフォトレジスト4を整布されたウエハ3を 及紋5を介して管着させ、照射光6の照射によりフォトマスク1のパターンでもウエハ3上に転写する。 税水化処理された密着面11は、吸水性が向上し、段被5の膜序を薄くする。



(74)代理人 弁理士 山川 政樹

(2)

特朗平4-305917

【特別確立の範囲】

【餅求項1】 投影光学系もしくはフォトマスクのウエ 八音者面を調水化処理し、この観水化処理された奇者面 にフォトレジストを設合されたウエハを提復を介して密 着させ、照針光の照射によりフォトマスクのパターンを 前記フォトレジストに転写するようにしたことを特徴と する密容型露光袋団。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、LSIの製造工程にお 10 うにした密若型露光袋母を提供することにある。 いて、フォトマスク上のパターンをウエハ上に役を居光 する母光表包、特に密容型露光装置に関するものであ

[0002]

【従来の技術】レーザー光等を照射しフォトマスク上の パターンを投影光学系によってシリコンウエハ等の学場 体基权上に投影解光するこの種の露光装置における解光 方式としては、①布着 (コンタクト) 電光方式、②プロ キシミティ蘇光方式、③反射型投影露光方式、⑤節ホレ ンズ登影摩光方式の4方式が知られている。

【0003】このうち密着露光方式は、フォトマスク (または投影光学系) とウエハとを密着させて開光する もので、これらが完全に任若している場合には、フォト レジスト中の波長が屈折率分の1に短くなるため、固折 の影響が少なく、高解像度の転写が得られるという特色 を有している。しかし、完全な豁着を実現することは極 めて難しく、またフォトマスクとウエハとを機械的に接 他させているためにウエハ衰菌の突起等によりフォトマ スクに欠陥が生じ、その寿命を低下させると同時にデバ イスの歩官りに影響を及ばすといった問題があった。

【0004】そこで、複雑像光方式によるこのような問 超を解決する方法としてフォトマスクとウエハ間に設体 (投設)を充填している。 図2は投影光学系にウエハを **告着させた場合を示すもので、1はフォトマスク、2は** 投影光学系の一部を構成する鍵光レンズ、3はフォトレ ジスト4が強布されたウエハ、5は底光レンズ2とウエ ハ3間に充填された侵族、6はフォトマスク1のパター ン?を照射しフォトレジスト4を保光する照射光、8は ウエハ3を保持する保持体、9は保持体8を上方に付勢 である。 照射光6の波長は短いほど回折の影響が少な く、そのため光源としてエキシマレーザー等のレーザー **荻澄が用いられる。役欲5としては、屈折率がフォトレ** ジスト4と同程度で光の吸収が少なく、しかもフォトレ ジスト4を溶かさないものが鑑定しく、過常純水が使用 される。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上述し たような受飲5を使用した密着型像光线目においては、 浸液5自身の旗厚ムラがあると、浸液5による原射光6 😥 電光装管によれば、投影光学系をたはフォトマスクのウ

の吸収量にムラが生じるため、コンタクト電光されたフ オトレジスト4のパターンが的磁に低光されている部分 とそうでない部分とが生じてしまうという問題があっ た。したがって、このような観光ムラの発生を防止する ため、提抜るの数写は1を得くし、光の仮収ムラを少な くすることが望まれている。

【0006】本発明は上途したような従来の問題点およ び要望に鑑みてなされたもので、その目的とするところ は、浸液の膜厚を輝くし、露光ムラを軽減防止し得るよ

100071

【政策を祭決するための手段】本発明は上記目的を登成 するため、投影光学系もしくはフォトマスクのウエハ密 特面を観水化処理し、この根水化処理された密着面にフ オトレジストを整布されたウエハを没被を介して告替さ せ、照射光の照射によりフォトマスクのパターンを前記 フォトレジストに転写するようにしたものである。

[8000]

【作用】本発明において、 報水化処理された投影光学系 20 もしくはフォトマスクのウエハ密着面は、吸水性が向上 し、受強の腹原を薄くする。

[0009]

【実施例】以下、本発明を図面に示す実施例に基づいて 詳細に説明する。 図1 は本発明に係る密着型離光装置の 一集施例を示す要部の断回盟である。なお、國中国2と 同一構成部品のものに対しては同一符号を以て示し、そ の説明を省略する。本実施例は投影光学系にウエハを密 **箱させた場合を示すもので、フォトマスク投影光学系の** 一部を構成する袰光レンズ2のウエハ密着面11を予め 80 親水化処理し、この穏水化処理された倍岩面11にウエ ハ3を施水等の侵骸5を介して香着させ、照射光6の展 新によりフォトマスク1のパターンでをウエハ3上に転 存するようにしたものである。

【0010】 穀水化処理は、アルコール系等の額水溶液 で密着面11を奇麗に拭き、レンズ表面の汚れを取るこ とで行なわれる。そして、この根水化処理後密着面11 にウエハ3を浸液5を介して治療させ、ウエハ3を爆光 レンズ2にばね9により所定圧にて押しつける。

【0011】かくしてこのような構成においては、親水 しウエハ3を電光レンズ2に押し付ける圧縮コイルばね 40 化処理によって密着面11の吸水性を向上させているの で、競水化処理を施さなかったときと比較して衰滅5の 吸水効果が大きく、したがって、浸液5の表面張力が小 さくなって濡れ性が上がるため、浸欲5の膜厚 d2 を図 2に示した従来装置と比較して難くする (d2 <d1) ことができ、また膜原が薄くなれば光の仮収量も少なく なるので、これに比例して光の吸収ムラが減少し、痞光 ムラを経済防止することができる。

[0012]

【発明の効果】以上説明したように本発明に係る密着型

http://www6.ipdl.jpo.go.jp/tjcontentdben.ipdl?N0000=21&N0400=image/gif&N0401=/NSA... 11/6/03

(3)

特開平4-305917

エハ密容面を個水化処理し、この観水化処理された密容 面に、フォトレジストを整布されたウエハを浸液を介し て密容させるように構成したので、浸液自身の表面強力 を減らして運れ性を向上させることができる。したがっ て、浸液の膜厚を輝くするができ、また膜厚が輝くなれ ば浸液の膜厚と与も少なくなるため、光の優収が少な く、浸液による露光ムラを軽減防止することができる。 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明に係る修着型像光装置の一実施例を示す 要部の街面図である。

【図2】密着型電光装配の従来例を示す妥協の転面図で

వర.

【符号の説明】

- 1 フォトマスク
- 2 観光レンズ
- 3 ウエハ
- 4 フォトレジスト
- 5 長液
- 6 颗射光
- 7 マスク
- 10 11 密着面

